製品カタログ

GaN電力増幅器

GaN パワーアンプは RF 電力段に窒化ガリウム素子を用います。完成したアンプの使用可能な出力は、バイアス制御、放熱経路、波形、負荷条件で決まります。

製品: 18

改訂: 14 · 改訂日: 2026-11-12





LCPAM-2000-6000-100-485

2–6 GHz 100 W GaN 広帯域 RF パワーアンプモジュール

LCPAM-2000-6000-100-485 は、GaN 技術を採用した 2–6 GHz の広帯域・高出力 RF パワーアンプモジュールです。標準飽和出力は 100 W、標準利得は 50 dB です。24–32 VDC で動作し、RS-485 インターフェース、状態監視、保護停止機能を備えています。50 Ω の RF システムの電力段として評価できます。

動作周波数: 記号: BW; 最小値: 2000; 最大値: 6000; 単位: MHz

飽和 RF 出力電力: 記号: Pout; 代表値: 100; 単位: W

電力利得: 記号: Gp; 代表値: 50; 単位: dB

動作電圧: 記号: VDC; 最小値: 24; 代表値: 28; 最大値: 32; 単位: VDC

特記なき場合：+28.0 VDC、25 °C、50 Ω システム

製品詳細　製品データシート



LCPAM-100-18000-5

100–18000 MHz GaN RFパワーアンプ、最小5 W

GaNアンプは100–18000 MHzをカバーし、飽和出力は最小5 W、標準7 Wです。利得は最小37 dB、標準38 dBで、標準平坦度は±0.5 dBです。

動作周波数: 記号: BW; 最小値: 100; 最大値: 18000; 単位: MHz

RF出力電力 @ PSAT: 記号: PSAT; 最小値: 5; 代表値: 7; 単位: W

電力利得 @ PSAT: 記号: Gp; 最小値: 37; 代表値: 38; 単位: dB

電力利得平坦度 @ PSAT: 記号: ΔGp; 代表値: ±0.5; 単位: dB

+28.0VDC; 25°C; 50Ω

製品詳細　製品データシート



LCPAM-10700-12700-100

10700–12700 MHz GaN RFパワーアンプ、標準100 W

GaNアンプは10700–12700 MHzで標準飽和出力100 W、標準利得50 dBを備えます。標準平坦度±1 dB、100 W出力時の標準高調波–50 dBcを規定しています。

動作周波数: 記号: BW; 最小値: 10700; 最大値: 12700; 単位: MHz

RF出力電力 @ PSAT: 記号: PSAT; 代表値: 100; 単位: W

電力利得 @ PSAT: 記号: Gp; 代表値: 50; 単位: dB

電力利得平坦度 @ PSAT: 記号: ΔGp; 代表値: ±1; 単位: dB

+28.0VDC; 25°C; 50Ω. 電源容量を決定する前に、動作電流と過電流保護の動作条件を LCRF にご確認ください。

製品詳細　製品データシート



LCPAM-10700-12700-50

10700–12700 MHz GaN RFパワーアンプ、標準50 W

GaNアンプは10700–12700 MHzで標準飽和出力50 W、標準利得47 dBを備えます。50 W時の標準動作電流は10 A、標準静止電流は1.6 Aです。

動作周波数: 記号: BW; 最小値: 10700; 最大値: 12700; 単位: MHz

RF出力電力 @ PSAT: 記号: PSAT; 代表値: 50; 単位: W

電力利得 @ PSAT: 記号: Gp; 代表値: 47; 単位: dB

電力利得平坦度 @ PSAT: 記号: ΔGp; 代表値: ±1; 単位: dB

+28.0VDC; 25°C; 50Ω

製品詳細　製品データシート



LCPAM-10700-12750-100

10700–12750 MHz GaN RFパワーアンプ、標準100 W、WR75アダプタ

GaNアンプは10700–12750 MHzで標準飽和出力100 W、最小利得50 dBを備えます。1 dB圧縮点の標準出力は40 W、100 W時の標準電流は21 Aです。

動作周波数: 記号: BW; 最小値: 10700; 最大値: 12750; 単位: MHz

1 dB圧縮点出力電力: 記号: P-1dB; 代表値: 40; 単位: W

RF出力電力 @ PSAT: 記号: PSAT; 代表値: 100; 単位: W

電力利得 @ PSAT: 記号: Gp; 最小値: 50; 単位: dB

+28.0VDC; 25°C; 50Ω

製品詳細　製品データシート



LCPAM-2000-6000-20

2000–6000 MHz GaN RFパワーアンプ、標準飽和出力25 W

本型番の仕様書は2000–6000 MHzで標準飽和出力25 W、標準利得44 dBを規定しています。標準電流2.5 Aと電力付加効率30%はいずれも20 W出力条件です。

動作周波数: 記号: BW; 最小値: 2000; 最大値: 6000; 単位: MHz

RF出力電力 @ PSAT: 記号: PSAT; 代表値: 25; 単位: W

電力利得 @ PSAT: 記号: Gp; 代表値: 44; 単位: dB

電力利得平坦度 @ PSAT: 記号: ΔGp; 代表値: ±1; 単位: dB

+28.0VDC; 25°C; 50Ω

製品詳細　製品データシート



LCPAM-3000-8000-100-485

3000–8000 MHz GaN RFパワーアンプ、標準100 W、RS-485

GaNアンプは3000–8000 MHzをカバーし、飽和出力は最小80 W、標準100 Wです。利得は最小49 dB、標準50 dBで、100 W出力時の標準電流は18 Aです。

動作周波数: 記号: BW; 最小値: 3000; 最大値: 8000; 単位: MHz

RF出力電力 @ PSAT: 記号: PSAT; 最小値: 80; 代表値: 100; 単位: W

電力利得 @ PSAT: 記号: Gp; 最小値: 49; 代表値: 50; 単位: dB

電力利得平坦度 @ PSAT: 記号: ΔGp; 代表値: ±2; 単位: dB

+28.0VDC; 25°C; 50Ω

製品詳細　製品データシート



LCPAM-30-1000-10

30–1000 MHz GaN RFパワーアンプ、標準10 W

GaNアンプは30–1000 MHzをカバーし、飽和出力は最小9 W、標準10 Wです。標準利得40 dB、平坦度±1 dB、10 W出力時の標準電流0.6 Aを規定しています。

動作周波数: 記号: BW; 最小値: 30; 最大値: 1000; 単位: MHz

RF出力電力 @ PSAT: 記号: PSAT; 最小値: 9; 代表値: 10; 単位: W

電力利得 @ PSAT: 記号: Gp; 代表値: 40; 単位: dB

電力利得平坦度 @ PSAT: 記号: ΔGp; 代表値: ±1; 単位: dB

+28.0VDC; 25°C; 50Ω

製品詳細　製品データシート



LCPAM-30-1500-1

30–1500 MHz GaN RFパワーアンプ、最小1 W

本モジュールは30–1500 MHzで最小飽和出力1 W、最小利得30 dBを規定しています。1 W時の標準電流は0.15 A、標準利得平坦度は±1 dBです。

動作周波数: 記号: BW; 最小値: 30; 最大値: 1500; 単位: MHz

RF出力電力 @ PSAT: 記号: PSAT; 最小値: 1; 単位: W

電力利得 @ PSAT: 記号: Gp; 最小値: 30; 単位: dB

電力利得平坦度 @ PSAT: 記号: ΔGp; 代表値: ±1; 単位: dB

+28.0VDC; 25°C; 50Ω

製品詳細　製品データシート



LCPAM-30-2000-1

30–2000 MHz GaN RFパワーアンプ、最小1 W

電気特性表に従い30–2000 MHzをカバーし、最小飽和出力1 W、最小利得30 dBを規定します。標準高調波は1 W時に−12 dBc、標準スプリアスは飽和時に−60 dBcです。

動作周波数: 記号: BW; 最小値: 30; 最大値: 2000; 単位: MHz

RF出力電力 @ PSAT: 記号: PSAT; 最小値: 1; 単位: W

電力利得 @ PSAT: 記号: Gp; 最小値: 30; 単位: dB

電力利得平坦度 @ PSAT: 記号: ΔGp; 代表値: ±1; 単位: dB

+28.0VDC; 25°C; 50Ω

製品詳細　製品データシート



LCPAM-5000-6000-100

5–6 GHz ≥100 W GaN RFパワーアンプモジュール

LCPAM-5000-6000-100は、5–6 GHzで飽和出力100 W以上、PSAT時の利得50 dB以上を規定しています。測定条件は28 VDC、25 °C、50 Ωです。

動作周波数: 記号: BW; 最小値: 5000; 最大値: 6000; 単位: MHz

飽和 RF 出力電力: 記号: PSAT; 最小値: 100; 単位: W; PSAT

電力利得 (PSAT): 記号: Gp; 最小値: 50; 単位: dB; PSAT

電力利得平坦度 (PSAT): 記号: ΔGp; 代表値: ±1; 単位: dB; PSAT

28 VDC; 25 °C; 50 Ω

製品詳細　製品データシート



LCPAM-5000-8500-25

5000–8500 MHz GaN RFパワーアンプ、標準25 W

GaNアンプは5000–8500 MHzをカバーし、飽和出力は最小20 W、標準25 Wです。利得は最小43 dB、標準44 dB、20 W出力時の標準高調波は–40 dBcです。

動作周波数: 記号: BW; 最小値: 5000; 最大値: 8500; 単位: MHz

RF出力電力 @ PSAT: 記号: PSAT; 最小値: 20; 代表値: 25; 単位: W

電力利得 @ PSAT: 記号: Gp; 最小値: 43; 代表値: 44; 単位: dB

電力利得平坦度 @ PSAT: 記号: ΔGp; 代表値: ±0.5; 単位: dB

+28.0VDC; 25°C; 50Ω

製品詳細　製品データシート



LCPAM-500-2500-100A

500–2500 MHz GaN RFパワーアンプ、標準100 W、A仕様

GaNのA仕様は500–2500 MHzをカバーし、標準飽和出力100 W、標準利得50 dBを備えます。100 W時の標準電流は12 Aで、高調波測定は70 W出力条件です。

動作周波数: 記号: BW; 最小値: 500; 最大値: 2500; 単位: MHz

RF出力電力 @ PSAT: 記号: PSAT; 代表値: 100; 単位: W

電力利得 @ PSAT: 記号: Gp; 代表値: 50; 単位: dB

電力利得平坦度 @ PSAT: 記号: ΔGp; 代表値: ±2; 単位: dB

+28.0VDC; 25°C; 50Ω 電気仕様表は最小26 VDC、標準28 VDC、最大30 VDCと記載していますが、A1 VDDの行は28–32 VDCです。A1の電源範囲は掲載していません。通電前に許容範囲とA1の配線を確認してください。ここでは32 VDCを確認済みの動作上限として扱いません。

製品詳細　製品データシート



LCPAM-6000-8500-20

6000–8500 MHz GaN RFパワーアンプ、最小20 W

本型番の仕様書では6000–8500 MHzで最小飽和出力20 W、標準25 Wを規定しています。標準電流2.5 Aと電力付加効率30%は20 W条件、標準静止電流は1.8 Aです。

動作周波数: 記号: BW; 最小値: 6000; 最大値: 8500; 単位: MHz

RF出力電力 @ PSAT: 記号: PSAT; 最小値: 20; 代表値: 25; 単位: W

電力利得 @ PSAT: 記号: Gp; 最小値: 43; 代表値: 44; 単位: dB

電力利得平坦度 @ PSAT: 記号: ΔGp; 代表値: ±0.5; 単位: dB

+28.0VDC; 25°C; 50Ω

製品詳細　製品データシート



LCPAM-6000-8500-25

6000–8500 MHz GaN RFパワーアンプ、標準25 W

本型番は6000–8500 MHzで標準飽和出力25 W、最小20 Wを規定しています。利得は標準44 dB、最小43 dB、標準利得平坦度は±0.5 dBです。

動作周波数: 記号: BW; 最小値: 6000; 最大値: 8500; 単位: MHz

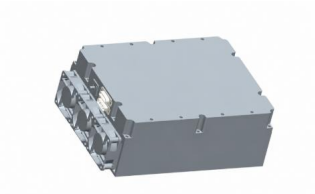
RF出力電力 @ PSAT: 記号: PSAT; 最小値: 20; 代表値: 25; 単位: W

電力利得 @ PSAT: 記号: Gp; 最小値: 43; 代表値: 44; 単位: dB

電力利得平坦度 @ PSAT: 記号: ΔGp; 代表値: ±0.5; 単位: dB

+28.0VDC; 25°C; 50Ω

製品詳細　製品データシート



LCPAM-8000-12000-100

8000–12000 MHz GaN RFパワーアンプ、標準100 W

GaNアンプは8000–12000 MHzで標準飽和出力100 W、最小利得53 dBを備えます。1 dB圧縮点の標準出力20 W、標準利得平坦度±1.5 dBを規定しています。

動作周波数: 記号: BW; 最小値: 8000; 最大値: 12000; 単位: MHz

1 dB圧縮点出力電力: 記号: P-1dB; 代表値: 20; 単位: W

RF出力電力 @ PSAT: 記号: PSAT; 代表値: 100; 単位: W

電力利得 @ PSAT: 記号: Gp; 最小値: 53; 単位: dB

+28.0VDC; 25°C; 50Ω

製品詳細　製品データシート



LCPAS-8000-12000-200

8000–12000 MHz GaN RFパワーアンプシステム、標準200 W

GaNシステムは8000–12000 MHzで標準飽和出力200 W、1 dB圧縮点の標準出力40 Wを備えます。最小利得53 dB、標準利得平坦度±1.5 dBを規定しています。

動作周波数: 記号: BW; 最小値: 8000; 最大値: 12000; 単位: MHz

1 dB圧縮点出力電力: 記号: P-1dB; 代表値: 40; 単位: W

RF出力電力 @ PSAT: 記号: PSAT; 代表値: 200; 単位: W

電力利得 @ PSAT: 記号: Gp; 最小値: 53; 単位: dB

+28.0VDC; 25°C; 50Ω

製品詳細　製品データシート



LCPAS-8000-12000-400

8000–12000 MHz GaN RFパワーアンプシステム、標準400 W

GaNシステムは8000–12000 MHzで標準飽和出力400 W、1 dB圧縮点の標準出力120 Wを規定しています。最小利得56 dB、標準利得平坦度±1.5 dBです。

動作周波数: 記号: BW; 最小値: 8000; 最大値: 12000; 単位: MHz

1 dB圧縮点出力電力: 記号: P-1dB; 代表値: 120; 単位: W

RF出力電力 @ PSAT: 記号: PSAT; 代表値: 400; 単位: W

電力利得 @ PSAT: 記号: Gp; 最小値: 56; 単位: dB

+28.0VDC; 25°C; 50Ω

製品詳細　　製品データシート

文書に関する注意

仕様は製品の更新に伴い改訂される場合があります。設計を確定する前に、現行の文書改訂版と製品固有の要件を LCRF に確認してください。供給構成は承認済みの見積書および注文書類で定義されます。